

## ★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 大見俊一郎 副委員長 宇佐美達矢

幹事 諏訪智之・野田泰史 幹事補佐 細井卓治・二瀬卓也

日時 1月30日(月) 13:10~16:55

会場 機械振興会館 (B3-1) (〒105-0011 港区芝公園3丁目5-8 東京メトロ日比谷線 神谷町駅下車 徒歩8分  
<http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/>)

議題 先端 CMOS デバイス・プロセス技術 (IEDM 特集)

1. [招待講演] セル面積極小化に向けた IGZO/Ge/2Si 異種チャネル 3次元集積型 6T SRAM の開発  
張 文馨 (産総研)
2. [招待講演] 高耐圧 CAAC-IGZO FET と  $0.06 \mu\text{m}^2$  の酸化ハフニウム系強誘電体材料を用いたデータ書き換え時間が 10 ns の FeRAM 大嶋和晃 (半導体エネルギー研)
3. [招待講演]  $10^7$  以上の書き換え耐性のあるはんだリフロー工程対応の eFlash 用 25 nmiPMA 型 Hexa-MTJ  
永沼 博 (東北大)
4. [招待講演] RonA と逆導通信頼性のトレードオフ改善を実現する SiC-MOSFET における効果的な SBD 内蔵構造  
朝羽俊介 (東芝)
5. [招待講演]  $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_3\text{S}_2$  を用いた不揮発性相変化中赤外光位相シフタ 宮武悠人 (東大)
6. [招待講演] 未来のテラヘルツ応用のための共鳴トンネルダイオード発振器 鈴木左文 (東工大)
7. [招待講演] IEDM2022 を振り返って

◆応用物理学会共催

【問合先】

高橋芳浩 (日大)

E-mail: [takahashi.yoshihiro@nihon-u.ac.jp](mailto:takahashi.yoshihiro@nihon-u.ac.jp)